

**(19) 대한민국특허청(KR)**  
**(12) 공개특허공보(A)**

**(51) Int. Cl.<sup>3</sup>**  
C23C 3/04

**(11) 공개번호** 특 1984-0006681  
**(43) 공개일자** 1984년 12월 01일

(21) 출원번호	특 1983-0005487
(22) 출원일자	1983년 11월 18일
(30) 우선권주장	442956 1982년 11월 19일 미국(US)
(71) 출원인	이 아이 뉴우판 디 네모아 앤드 캄파니 도늘드 에이 호우스 미합중국 데라웨아주 19898 월밍تون시 제10 및 마야캐스 스트리이츠
(72) 발명자	죠오지프 앤튼 오스왈드 쥬니어 미합중국 펜실베이니아주 17055 미캐닉스버어그시 인디안 크리이크 드라이 브 216
(74) 대리인	차윤근, 차순영

**심사청구 : 없음****(54) 단자 접점용 금속박막 형성 공정****요약**

내용 없음

**대표도****도 1****명세서**

[발명의 명칭]

단자 접점용 금속박막 형성 공정

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 공정의 양식화된 전개도.

제2도는 유도 가열 부분의 단면도.

제3도는 일련의 금속띠 상에 귀금속 막이 형성된 단면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

**(57) 청구의 범위****청구항 1**

금속띠를 스크린 인쇄 영역에 넣어 거기서 금속띠 상의 미리 지정된 지점에 두꺼운 귀금속막 용접을 구성체가 놓여지고, 그 다음 금속띠가 유도 가열 코일에 들어가게 되어 금속띠 상의 금속막 구성체가 비활성 가스의 존재하에 가열되어지는 공정을 포함하는 공정을 전기 단자를 구성하기에 적합한 금속띠 상에 귀금속 접점 영역을 형성시키는 공정.

**청구항 2**

제1항에 있어서 귀금속으로 금을 사용하는 공정.

**청구항 3**

제1항에 있어서 은을 사용하는 공정.

**청구항 4**

제1항에 있어서 팔라듐을 사용하는 공정.

**청구항 5**

제1항에 있어서 귀금속의 합금을 사용하는 공정.

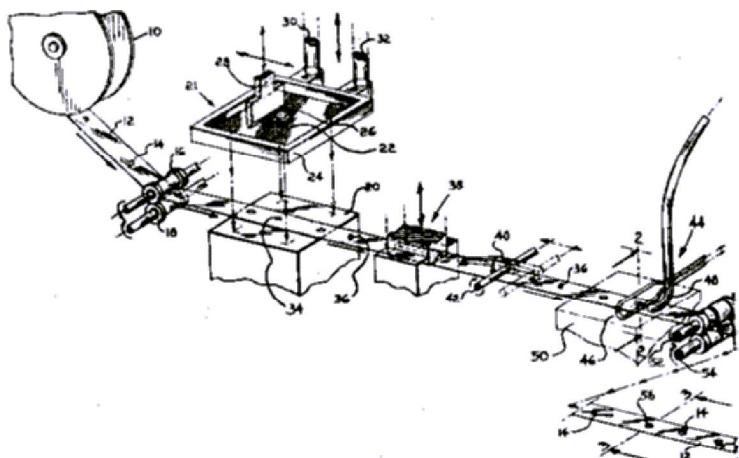
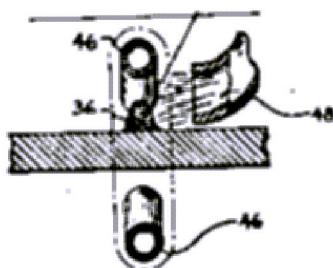
**청구항 6**

제1항에 있어서 귀금속이 금이고, 두꺼운 막의 용접을 구성체가 미세한 금입자 65-97중량%와 완전한 무기 고체로 된 카드뮴과 안티몬 합금의 미세한 입자 3-25중량%에 충분한 비활성 액체를 섞어 용접들을 조성하는 과정.

**청구항 7**

제1항에서 제6항에 있어서 질소의 존재하에 700-900°C에 약 1초간 유도 가열이 행해지는 공정.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

**도면****도면1****도면2****도면3**